SZX 21/1; 5,1 . . . 24 △

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehäuse. Sie dienen zur Spannungsstabilisierung und -begrenzung sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

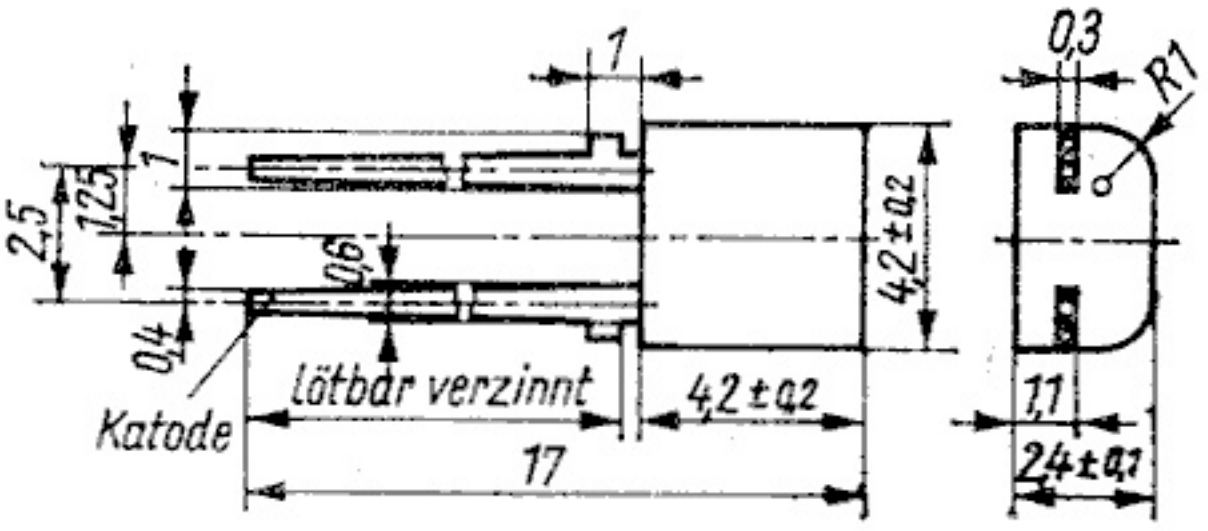
Die Z-Dioden SZX 21 werden in der E 24-Reihe (5%) geliefert.

Grenzwerte

Gesamtverlustleistung	P_{tot}	400 mW[1])
	P_{tot}	250 mW[2])
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	150 °C
Wärmewiderstand	R_{th}	0,31 K/mW[1])
	R_{th}	0,5 K/mW[2])
Lagerungstemperaturbereich	ϑ_{stg}	−50 . . . +50 °C
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	−55 . . . +100 °C

[1]) Angaben gelten, wenn Anschlußdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf einer Temperatur von $\vartheta_a = 25$ °C gehalten werden

[2]) ohne zusätzliche Kühlung



Kennwerte bei $\vartheta_a = 25$ °C

Typ	Z-Spannung U_Z/V	Z-Widerstand r_z/Ohm	Sperrspannung U_R/V	rel. Temperaturkoeff. der Z-Spannung TK_{UZ}/%/K
	bei I_Z = −5 mA		bei $I_R = 1\ \mu A$	
SZX 21/1[1])	0,73 . . . 0,83	8	–	− 0,22 . . . − 0,18
SZX 21/5,1	4,8 . . . 5,4	60	0,8	− 0,05 . . . + 0,03
SZX 21/5,6	5,2 . . . 6,0	40	1	− 0,02 . . . + 0,05
SZX 21/6,2	5,8 . . . 6,6	10	1	− 0,01 . . . + 0,06
SZX 21/6,8	6,4 . . . 7,2	8	2	− 0,00 . . . + 0,07
SZX 21/7,5	7,0 . . . 7,9	7	2	+ 0,02 . . . + 0,07
SZX 21/8,2	7,7 . . . 8,7	7	3,5	+ 0,03 . . . + 0,07
SZX 21/9,1	8,5 . . . 9,6	10	3,5	+ 0,04 . . . + 0,08
SZX 21/10	9,4 . . . 10,6	15	5	+ 0,05 . . . + 0,08
SZX 21/11	10,4 . . . 11,6	20	5	+ 0,05 . . . + 0,08
SZX 21/12	11,4 . . . 12,8	20	7	+ 0,06 . . . + 0,09
SZX 21/13	12,6 . . . 14,0	25	7	+ 0,065 . . . + 0,09
SZX 21/15	13,8 . . . 15,5	30	10	+ 0,07 . . . + 0,09
SZX 21/16	15,3 . . . 17,0	40	10	+ 0,07 . . . + 0,09
SZX 21/18	16,8 . . . 19,0	55	10	+ 0,07 . . . + 0,09
SZX 21/20	18,8 . . . 21,0	55	10	+ 0,07 . . . + 0,09
SZX 21/22	20,8 . . . 23,0	55	12	+ 0,07 . . . + 0,09
SZX 21/24	22,8 . . . 25,6	80	12	+ 0,075 . . . + 0,095

Durchlaßspannung bei $I_F = 50$ mA, $U_F \leq 1$ V

[1]) wird in Durchlaßrichtung betrieben